

HSR101

シリコンエピタキシャルプレーナ形
 ショットキバリアダイオード
 一般検波, 超高速スイッチング用

SILICON EPITAXIAL PLANAR SCHOTTKY
 BARRIER DIODE
 VARIOUS DETECTOR, VERY HIGH SPEED
 SWITCHING

特 長 FEATURES

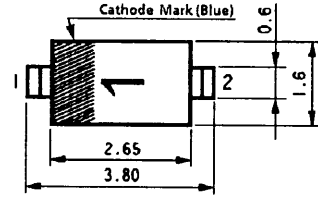
- 逆方向電流が極めて低い。
- 順方向立ち上り電圧が低く高効率です。
- 小形レジン外形で高密度実装可能です。
- Low V_F and High efficiency.
- Very low I_R .
- Small Resin Package (SRP) for high density mounting.

絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

(特に指定のない場合は, 周囲温度 $T_a = 25^\circ\text{C}$)
 (25°C ambient temperature unless otherwise specified.)

項目	Symbol	HSR101	Unit
逆電圧	V_R	30	V
順電流	I_F	35	mA
接合部温度	T_J	100	°C
保存温度	T_{stg}	-55 ~ +100	°C
許容損失	P_d	150	mW

外 形 図



(SRP)

1. カソード: Cathode
 2. アノード: Anode
- (Dimensions in mm)

電 気 的 特 性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

(特に指定のない場合は, 周囲温度 $T_a = 25^\circ\text{C}$)
 (25°C ambient temperature unless otherwise specified.)

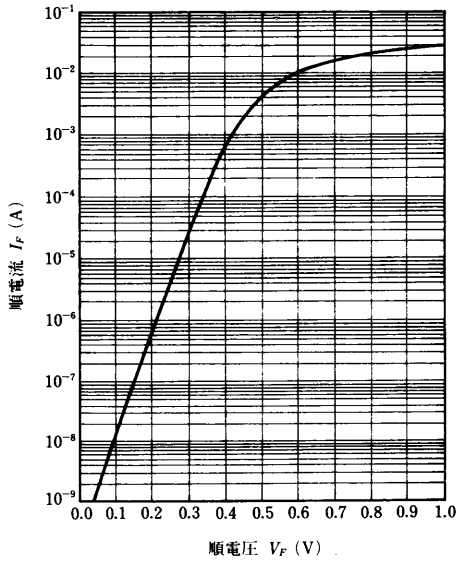
項 目	Symbol	Test Condition	Min	Typ	Max	Unit
逆電流	I_R	$V_R = 10\text{V}$	-	-	10	nA
逆電圧	V_R	$I_R = 10\mu\text{A}$	30	-	-	V
順電圧	V_F	$I_F = 10\text{mA}$	-	-	0.70	V
端子間容量	C	$V_R = 0\text{V}, f = 1\text{MHz}$	-	-	1.50	pF
端子間容量偏差	ΔC	$V_R = 0\text{V}, f = 1\text{MHz}$	-	-	± 0.05	pF
順電圧偏差	ΔV_F	$I_F = 10\text{mA}$	-	-	± 5.00	mV

* 組内の数量は4N (Nは整数) と致します。

* Each group shall uniform a multiple of 4 diodes.

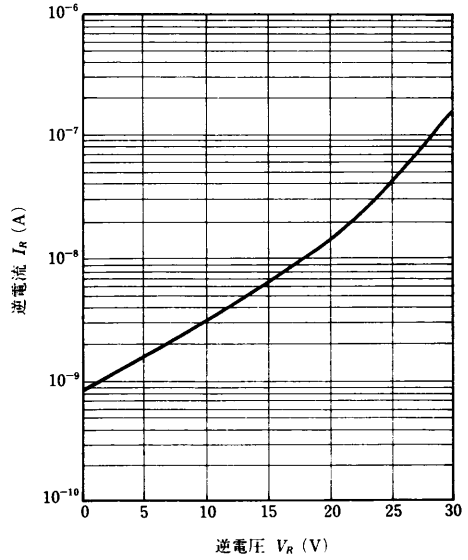
順特性

FORWARD CURRENT VS. FORWARD VOLTAGE



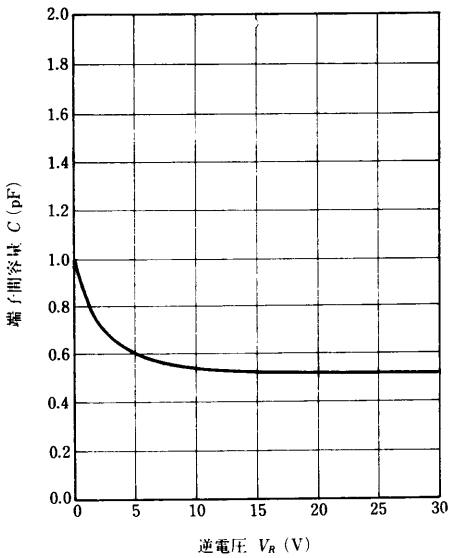
逆特性

REVERSE CURRENT VS. REVERSE VOLTAGE



端子間容量 対 逆電圧特性

CAPACITANCE VS. REVERSE VOLTAGE



HSR276

シリコンショットキバリア形
チューナミキサ, コンバータ用

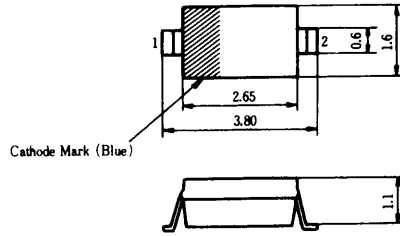
SILICON SCHOTTKY BARRIER
TUNER MIXER, CONVERTER

■特長

- 高順電流, 低静電容量です。
- 小形レジン外形のため, 面装着により高密度実装が可能です。

■FEATURES

- High forward current, low capacitance.
- Small resin mold package suitable for surface mount design.



(SRP)

■絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

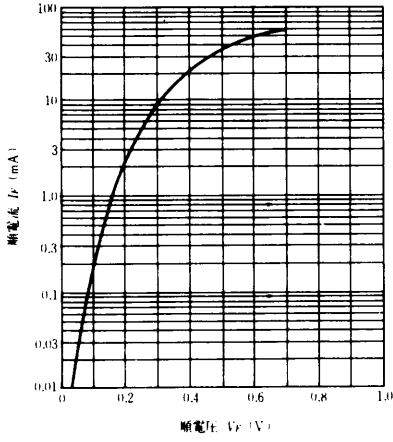
項	目	Symbol	HSR276	Unit
逆	電 圧	V_R	3	V
平 均	整 流 電 流	I_O	30	mA
接 合 部	温 度	T_j	125	$^\circ\text{C}$
保 存	温 度	T_{stg}	-55~+125	$^\circ\text{C}$

■電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項	目	Symbol	Test Condition	min.	typ.	max.	Unit
逆	電 圧	V_R	$I_R=1\text{mA}$	3	—	—	V
逆	電 流	I_R	$V_R=0.5\text{V}$	—	—	50	μA
順	電 流	I_F	$V_F=0.5\text{V}$	35	—	—	mA
端 子 間	容 量	C	$V_R=0.5\text{V}, f=1\text{MHz}$	—	—	0.85	pF

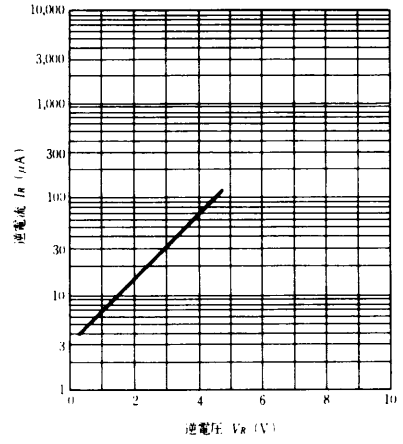
順特性

FORWARD CHARACTERISTICS



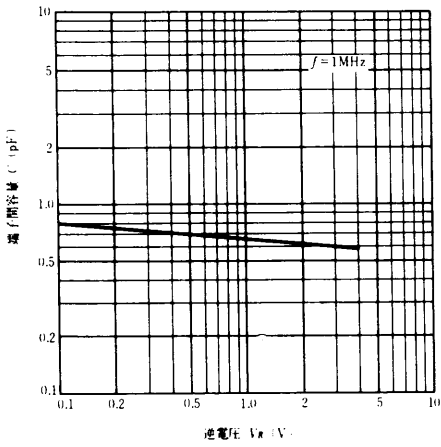
逆特性

REVERSE CHARACTERISTICS



端子間容量对逆電圧特性

CAPACITANCE VS. REVERSE VOLTAGE



HSR277

シリコンエピタキシャルプレーナ形
UHF/VHF チューナバンドスイッチ用

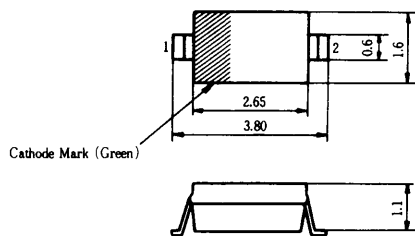
SILICON EPITAXIAL PLANAR
BAND SWITCHING IN UHF/VHF TUNER

■特長

- 低順動作抵抗であるため、挿入損失を小さくできます。
- 小形レジン外形のため面装着により、高密度実装ができます。

■FEATURES

- Low forward resistance.
- Good for surface mounting on printed circuit board.



1. カソード: Cathode
 2. アノード: Anode
- (Dimensions in mm)

(SRP)

■絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

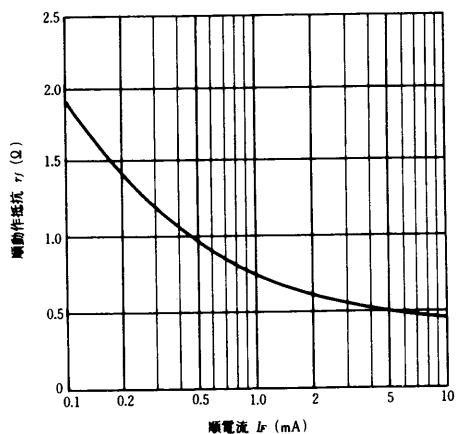
項目	Symbol	HSR277	Unit
逆電圧	V_R	35	V
接合部温度	T_j	125	$^\circ\text{C}$
許容損失	P_d	150	mW
動作温度	T_{opr}	-20 ~ +60	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-45 ~ +125	$^\circ\text{C}$

■電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

項目	Symbol	Test Condition	min.	typ.	max.	Unit
逆電流	I_R	$V_R = 25\text{V}$	—	—	50	nA
順電圧	V_F	$I_F = 10\text{mA}$	—	—	1.0	V
端子間容量	C	$V_R = 6\text{V}, f = 1\text{MHz}$	—	—	1.2	pF
順動作抵抗	r_f	$I_F = 2\text{mA}, f = 100\text{MHz}$	—	—	0.9	Ω

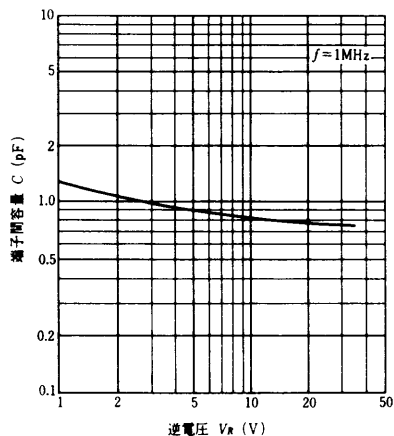
順動作抵抗対順電流特性

FORWARD RESISTANCE VS. FORWARD CURRENT



端子間容量対逆電圧特性

CAPACITANCE VS. REVERSE VOLTAGE



順動作抵抗対周波数特性

FORWARD RESISTANCE VS. FREQUENCY

